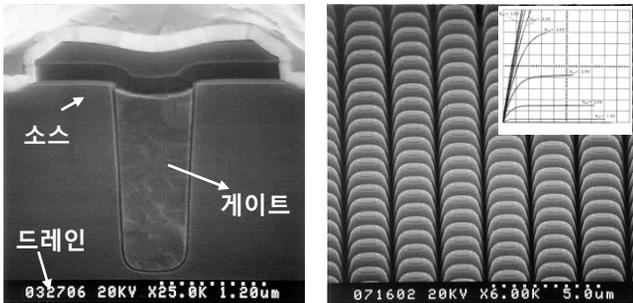


/ 기술 개요

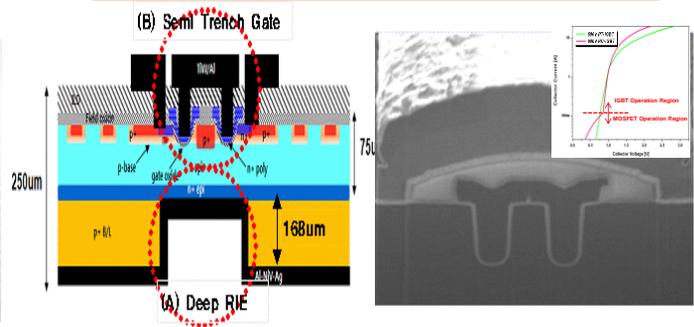
- 40~200V급 고집적 Trench Gate DMOS (TDMOS) 기술
- FRD 내장 600V급 Reverse Conducting IGBT (RC-IGBT) 및 Semi-Trench 적용 1200V NPT IGBT 기술
- 낮은 전압손실, 빠른 역회복시간, 고온안정성 및 높은 EAS 특성을 갖는 Super Barrier Rectifier (SBR)
- 400V LDMOS, CMOS, BJT 및 Diode가 내장된 전력 집적회로 기술 등

/ 주요 개발 사례

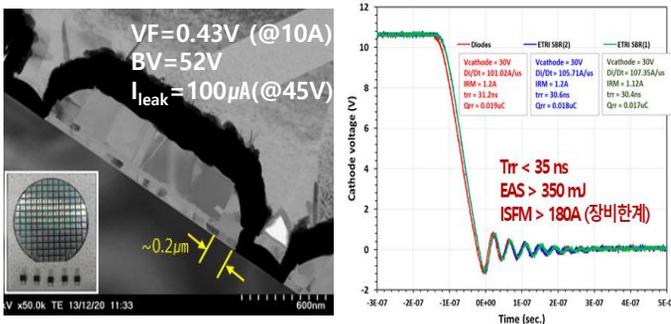
40~200V Trench Gate DMOS (TDMOS)



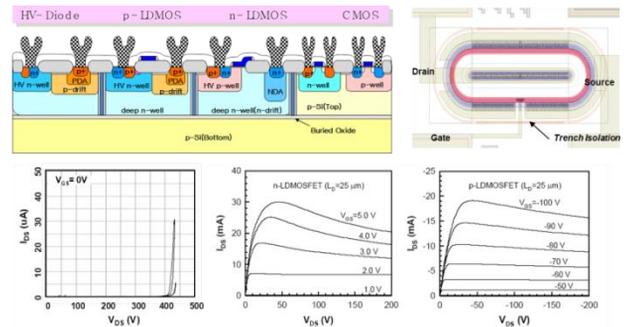
600V RC-IGBT, 1200V NPT IGBT



45~100V Super Barrier Rectifier (SBR)



400V 급 고내압 전력 집적회로



/ 활용 분야

- 전력변환 및 제어용 각종 부품, 자동차 Relay & Switch, DC-DC Converters, Power Management 등
- 자동차용 전력소자, 가전/산업용 Motor, 신재생 에너지, Battery Charging System 등
- Automotive용 전력정류기, Solar Panel By-pass Diode, 모바일 충전용 정류기, PC Power SMPS 등
- 전압안정기 집적회로, PDP 등 디스플레이 구동 IC, Smart Power IC 등